

IEEE EDS Kansai Chapterの皆様
IEEE Kansai Section の皆様

2019年8月5日
IEEE EDS Kansai Chapter Chair 吉本 昌広
Vice Chair 渡辺 博文

下記の通り、第19回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」を開催致します。
会員の皆様のご参加をお待ち申し上げます。

記

会議名：第19回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」
主 催：IEEE Electron Devices Society Kansai Chapter
日 時：2019年9月24日(火) 10:00～15:35
会 場：龍谷大学大阪梅田キャンパス セミナールーム
場 所：〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー14階

プログラム：次ページ以降参照
公用語：日本語
会 費：無料(事前登録不要)

[お問い合わせ先]
IEEE EDS Kansai Chapter Secretary: 西中 浩之 (京都工芸繊維大学; nisinaka@kit.ac.jp)

=====

<ご講演頂く皆様へ>

講演時間:20分 + 質疑:5分 (全て日本語)
使用器具:講演で使用していただくPCは原則ご持参ください。もしご都合が悪いようでしたら、事前に鎌倉(大工大, yoshinari.kamakura@oit.ac.jp)までご連絡ください。その場合、Power Pointデータを事前に上記アドレス宛お送りいただくか、当日USBスティックメモリをご持参ください。
当日、特別な資料をご用意いただく必要はありません。

開会挨拶 [10:00 - 10:05]

渡辺 博文（リコー）

Session I. **Sensor, Solar Cell, and Emerging Devices [10:05-11:45]**

座長：積 知範（オムロン）

Flexible Tri-Axis Tactile Sensor Using Spiral Inductor and Magnetorheological Elastomer [IEEE Sensors J.]

T. Kawasetsu, T. Horii, H. Ishihara, and M. Asada
Osaka University

Self-Heating Suppressed Structure of a-IGZO Thin-Film Transistor [IEEE EDL]

K. Kise, M. N. Fujii, J. P. Bermundo, Y. Ishikawa, and Y. Uraoka
Nara Institute of Science and Technology

Logic Circuits Consisting of Pentacene Thin-Film Transistors with Controlled Threshold Voltages [SSDM]

H. Takahashi, M. Kitamura, Y. Hattori, and Y. Kimura
Kobe University

Nonlinear Optical Properties of Lead Halide Perovskites [AMFPD]

H. Tahara, T. Yamada, T. Handa, and Y. Kanemitsu
Kyoto Univ.

— 休憩 [11:45-13:00] —

Session II. **CMOS Process, Device, and Circuit [13:00-13:50]**

座長：岡田 健治（パナソニック・タワージャズ セミコンダクター）

Sensitivity to Soft Errors of NMOS and PMOS Transistors Evaluated by Latches with Stacking Structures in a 65 nm FDSOI Process [IRPS]

K. Yamada, H. Maruoka, J. Furuta, and K. Kobayashi
Kyoto Insititute of Technology

CMOS-Integrated Optical Power Transfer for an Ultra-Small Wireless Implantable Devices [SSDM]

P. Thanet¹, W. Nattakarn¹, M. Haruta¹, T. Noda¹, K. Sasagawa¹, T. Tokuda¹,
M. Sawan², and J. Ohta¹

¹Nara Institutes of Science and Technology, ²Polytechnique Montréal

— 休憩 [13:50-14:00] —

Session III. **Power and Compund Semiconductor Devices [14:00-15:15]**

座長：加藤 貴敏（村田製作所）

Channel Engineering of 4H-SiC MOSFETs Using Sulphur as a Deep Level Donor [IEDM]

M. Noguchi¹, T. Iwamatsu¹, H. Amishiro¹, H. Watanabe¹, K. Kita², and N. Miura¹
Mitsubishi Electric Corporation

Parallel-Plane Breakdown Fields of 2.8-3.5 MV/cm in GaN-on-GaN p-n Junction Diodes with Double-Side-Depleted Shallow Bevel Termination [IEDM]

T. Maeda¹, T. Narita², H. Ueda², M. Kanechika², T. Uesugi², T. Kachi³, T. Kimoto¹, M. Horita¹, and J. Suda^{1,3}

¹Kyoto University, ²Toyota Central R&D Labs., Inc., ³Nagoya University

Monolithically Integrated E-mode GaN-on-SOI Gate Driver with Power GaN-HEMT for MHz-Switching [WiPDA]

Y. Yamashita¹, S. Stoffelsy², N. Posthumay², S. Decouterey², and K. Kobayashi¹

¹Kyoto Institute of Technology, ²IMEC

AWARD授与 [15:15-15:30]

上田 尚宏 (リコー電子デバイス)

閉会挨拶 [15:30-15:35]

渡辺 博文 (リコー)